

SOT223 NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

FZT658

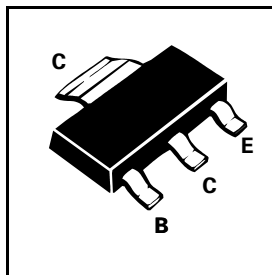
ISSUE 4 - OCTOBER 1995

FEATURES

- * 400 Volt V_{CE0}
- * Low saturation voltage

COMPLEMENTARY TYPE - FZT758

PARTMARKING DETAIL - FZT658



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	400	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	400	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1	A
Continuous Collector Current	I_C	0.5	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

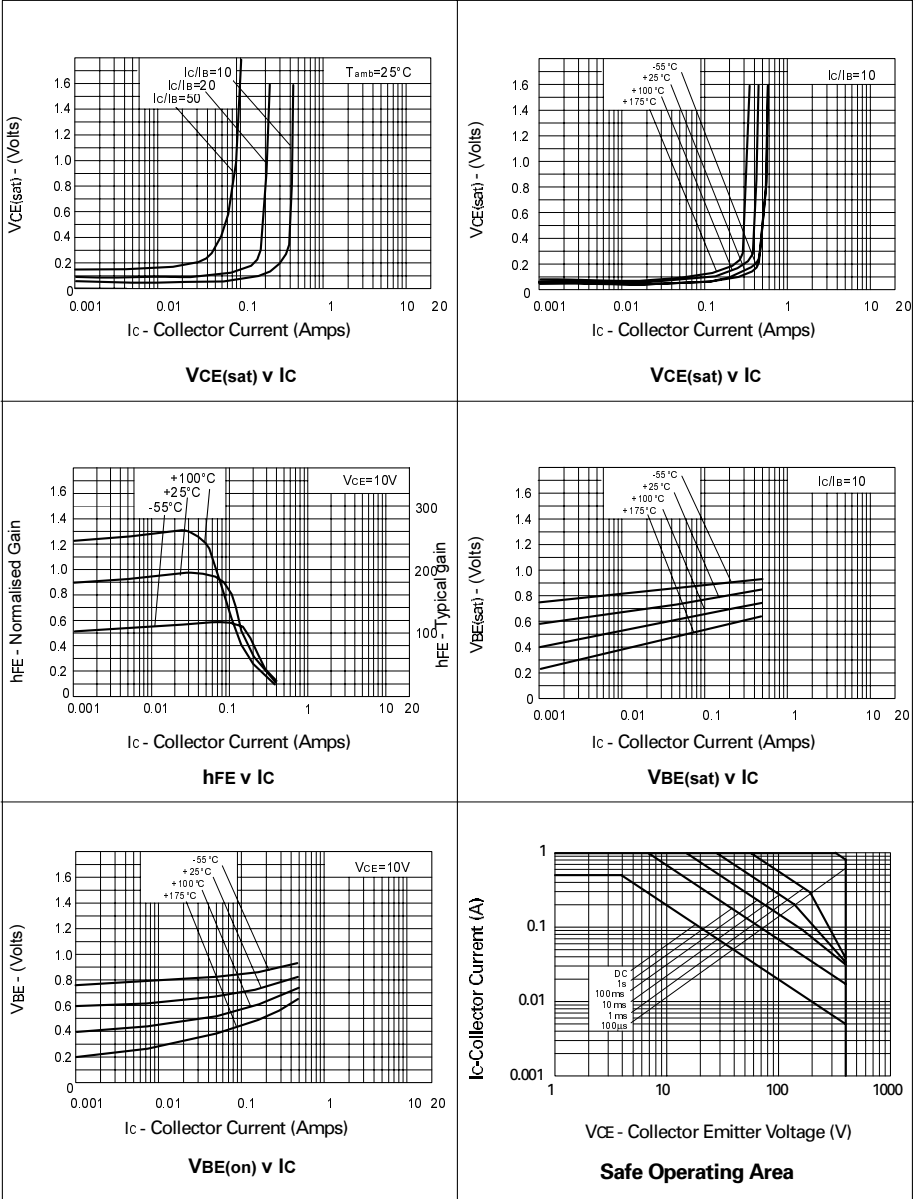
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	400		V	$I_C=100\mu A$
	$V_{(BR)CEO}$	400		V	$I_C=10mA^*$
	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E=100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		100	nA	$V_{CB}=320V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		100	nA	$V_{EB}=4V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.3	V	$I_C=20mA, I_B=1mA^*$
			0.25	V	$I_C=50mA, I_B=5mA^*$
			0.5	V	$I_C=100mA, I_B=10mA$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.9	V	$I_C=100mA, I_B=10mA^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.0	V	$I_C=100mA, V_{CE}=5V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	50			$I_C=1mA, V_{CE}=5V^*$
		50			$I_C=100mA, V_{CE}=5V^*$
		40			$I_C=200mA, V_{CE}=10V^*$
Transition Frequency	f_T	50		MHz	$I_C=10mA, V_{CE}=20V$ $f=20MHz$
Output Capacitance	C_{obo}		10	pF	$V_{CB}=20V, f=1MHz$
Switching Times	t_{on}		130	ns	$I_C=100mA, V_{CC}=100V$
	t_{off}		3300	ns	$I_{B1}=10mA, I_{B2}=-20mA$

*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
Spice parameter data is available upon request for this device

FZT658

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9